

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА**

Фізико-технічний факультет  
Кафедра комп'ютерної інженерії та електроніки

**СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Комп'ютерне моделювання технологій ІС**

Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Освітньо-наукова програма «Електроніка»

Спеціальність 171 Електроніка

Галузь знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

Затверджено на засіданні кафедри  
Протокол №12 від 30 червня 2023 р.

Івано-Франківськ – 2023 рік

<b>1. Загальна інформація</b>	
<b>Назва дисципліни</b>	Комп'ютерне моделювання технологій ІС
<b>Викладач (-і)</b>	професор, доктор фізико-математичних наук Мандзюк Володимир Ігорович
<b>Контактний телефон викладача</b>	0342596007
<b>e-mail викладача</b>	volodymyr.mandzyuk@pnu.edu.ua
<b>Формат дисципліни</b>	Очний, дистанційний
<b>Обсяг дисципліни</b>	3 кредити ЄКТС, 90 год.
<b>Посилання на сайт дистанційного навчання</b>	<a href="https://d-learn.pnu.edu.ua/">https://d-learn.pnu.edu.ua/</a>
<b>Консультації</b>	відповідно до графіку індивідуальних консультацій, який розміщений на інформаційному стенді кафедри комп'ютерної інженерії та електроніки
<b>2. Анотація до навчальної дисципліни</b>	
<p>Дисципліна “Комп'ютерне моделювання технологій ІС” належить до переліку обов'язкових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки за освітнім рівнем “доктор філософії”, що пропонуються в рамках циклу професійної підготовки аспірантів за освітньо-науковою програмою “Електроніка”. Вона забезпечує формування у аспірантів науково-дослідницьких професійно-орієнтованих компетенцій.</p> <p>Силабус навчальної дисципліни “Комп'ютерне моделювання технологій ІС” складений відповідно до освітньо-наукової програми “Електроніка” з підготовки докторів філософії спеціальності 171 “Електроніка” галузі знань 17 “Електроніка, автоматизація та електронні комунікації”.</p>	
<b>3. Мета та цілі навчальної дисципліни</b>	
<p><b>Метою</b> навчальної дисципліни “Комп'ютерне моделювання технологій ІС” є моделювання базових технологічних процесів, що використовуються для виготовлення пристроїв мікро- і наноелектроніки.</p> <p>Основним <b>завданням</b> навчальної дисципліни є ознайомлення аспірантів з основними технологічними операціями, які використовуються при виготовленні інтегральних схем (ІС), та принципами їх математичного моделювання.</p> <p>У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен <b>знати:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– основні технологічні процеси, які використовуються в технології виготовлення ІС, та фізико-хімічні явища, які лежать в основі даних процесів;</li> <li>– послідовність проведення технологічних процесів при формуванні ІС;</li> <li>– способи формування інтегральних діодів, конденсаторів і резисторів, їх основні параметри та способи ізоляції елементів інтегральних схем;</li> <li>– основи технології та послідовність етапів виробництва напівпровідникових приладів на основі біполярних, МОН-, КМОН-транзисторів та інших типів ІС.</li> </ul> <p><b>вміти:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– оптимізувати процеси нанесення матеріалу в магнетронній системі розпилення для одержання тонких плівок бажаної товщини та нерівномірності;</li> <li>– розраховувати характеристики розподілу концентрації заданої домішки в кремнії при одностадійній та двохстадійній дифузії для отримання <i>p-n</i>-переходу на заданій глибині і потрібній її поверхневій концентрації;</li> <li>– формувати біполярний транзистор з необхідною шириною бази та емітера, використовуючи роздільну дифузію домішок;</li> <li>– розрахувати характеристики уповільнення іонів при імплантації та параметри розподілу домішки в кремнії;</li> <li>– складати технологічний маршрут формування інтегральних елементів в залежності від його функціонального призначення.</li> </ul>	

#### 4. Програмні компетентності та результати навчання

Здатність продукувати нові ідеї, здатність розв'язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері електроніки, застосовувати методологію наукової та педагогічної діяльності, проводити власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

ЗК2. Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел.

СК1. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання у електроніці та дотичних до неї міждисциплінарних напрямках і можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях з електроніки та суміжних галузей.

СК4. Здатність використовувати сучасні інструменти та методи дослідження, методи моделювання, аналізу даних та оптимізації, системи прийняття рішень, цифрові технології, бази даних та інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення для дослідження об'єктів і процесів електроніки.

СК5. Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні інноваційні в сфері електроніки та дотичні до неї міждисциплінарні проекти.

СК6. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій освіті з використанням новітніх педагогічних підходів і практик, у тому числі інформаційних технологій, засобів мультимедіа у навчальному процесі для україномовної та іншомовної аудиторії, урізноманітнювати методики викладання з метою кращого сприйняття матеріалу.

СК9. Здатність обирати ефективні системи автоматизованого проектування, здійснювати проектування ІС, мікросистем на кристалі, програмування ПЛІС.

ПРН1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з електроніки і на межі предметних галузей, а також універсальні дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного напрямку, отримання нових знань, їх використання у власних дослідженнях та викладацькій практиці.

ПРН3. Вміти формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для обґрунтування висновків належні докази, зокрема, результати теоретичного аналізу, експериментальних досліджень, фізичного, математичного та комп'ютерного моделювання, наявні літературні дані.

ПРН4. Вміти розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і комп'ютерні моделі процесів і систем, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або створення інноваційних продуктів у електроніці та дотичних міждисциплінарних напрямках, у науково-педагогічній діяльності.

ПРН6. Планувати, організовувати роботу в галузі наукових досліджень, розробки, аналізу, розрахунку, моделювання, виробництва та тестування електронних пристроїв та систем.

ПРН8. Вміння застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу даних великого обсягу та/або складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи.

ПРН11. Вміти організовувати і здійснювати освітній процес у сфері електроніки, його наукове, навчально-методичне та нормативне забезпечення, розробляти і викладати спеціальні навчальні дисципліни у закладах вищої освіти. Володіти навичками етичної поведінки в інформаційно-комунікаційному середовищі.

ПРН12. Здійснювати критичний аналіз та застосовувати знання, вміння і наукові досягнення для розв'язування задач синтезу та аналізу елементів та систем в галузі

електроніки та суміжних галузях, знаходити засоби розв'язання проблем і прогнозувати майбутні наслідки прийнятих рішень.			
<b>5. Організація навчання</b>			
Обсяг навчальної дисципліни			
Вид заняття		Загальна кількість годин	
лекції		20	
лабораторні		10	
самостійна робота		60	
<b>Ознаки курсу</b>			
Семестр	Спеціальність	Курс (рік навчання)	Нормативний / вибірковий
1	171 Електроніка	1	Нормативний
<b>Тематика навчальної дисципліни</b>			
Тема	Кількість год		
	Лекції	Лаб. заняття	Сам. робота
<b>Тема 1.</b> Механічна та хімічна обробка поверхні напівпровідникових пластин для пристроїв інтегральної електроніки.	2		6
<b>Тема 2.</b> Формування діелектричних плівок на напівпровідникових пластинах.	2		6
<b>Тема 3.</b> Літографічні процеси в технології виробництва ІС. Еліонні методи літографії.	2		6
<b>Тема 4.</b> Особливості проведення дифузії при виготовленні ІС.	2	3	6
<b>Тема 5.</b> Іона імплантація як спосіб легування в при виробництві ІС.	2	3	6
<b>Тема 6.</b> Технологія епітаксійних шарів та методи її проведення.	2		4
<b>Тема 7.</b> Технології металізації при виготовленні ІС.	2	2	6
<b>Тема 8.</b> Елементна база інтегральних схем. Інтегральні діоди. Інтегральні резистори. Інтегральні конденсатори. Ізоляція елементів інтегральних схем.	2		4
<b>Тема 9.</b> Основні типи структур ІС.	2		8
<b>Тема 10.</b> Технологія гібридних ІС.	2	2	8
ЗАГ:	20	10	60
<b>6. Система оцінювання навчальної дисципліни</b>			
Загальна система оцінювання курсу	<p><i>Поточний контроль</i> здійснюється під час проведення лекційних, лабораторних, індивідуальних занять і має на меті перевірку знань аспірантів з окремих тем навчальної дисципліни та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи. Оцінки у національній шкалі («відмінно» - 5, «добре» - 4, «задовільно» - 3, «незадовільно» - 2), отримані аспірантами, виставляються у журналах обліку відвідування та успішності курсу аспірантів зі спеціальності 171 Електроніка.</p> <p>Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу (теми), вироблення</p>		

	<p>навичок проведення дослідницьких робіт при моделюванні технологічних процесів виготовлення ІС використанням пакетів прикладних математичних програм, вміння вирішувати конкретні ситуативні завдання, приймати рішення щодо подальших досліджень на основі отриманих результатів.</p> <p>Семестровий контроль проводиться у формі <i>заліку</i>.</p> <p><i>Залік</i> – форма підсумкового контролю, яка передбачає перевірку розуміння аспірантом теоретичного та практичного програмного матеріалу з предмету “Комп’ютерне моделювання технологій ІС”, здатності творчо використовувати здобуті знання та вміння, формувати власне ставлення до певної проблеми тощо.</p> <table border="1" data-bbox="671 629 1463 1272"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Сума балів за всі види навчальної діяльності</th> <th rowspan="2">Оцінка ECTS</th> <th colspan="2">Оцінка за національною шкалою</th> </tr> <tr> <th>Для екзамену</th> <th>Для заліку</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90 – 100</td> <td><b>A</b></td> <td>відмінно</td> <td rowspan="5">зараховано</td> </tr> <tr> <td>80 – 89</td> <td><b>B</b></td> <td rowspan="2">добре</td> </tr> <tr> <td>70 – 79</td> <td><b>C</b></td> </tr> <tr> <td>60 – 69</td> <td><b>D</b></td> <td rowspan="2">задовільно</td> </tr> <tr> <td>50 – 59</td> <td><b>E</b></td> </tr> <tr> <td>26 – 49</td> <td><b>FX</b></td> <td>незадовільно з можливістю повторного складання</td> <td>не зараховано з можливістю повторного складання</td> </tr> <tr> <td>0-25</td> <td><b>F</b></td> <td>незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни</td> <td>не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни</td> </tr> </tbody> </table>	Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою		Для екзамену	Для заліку	90 – 100	<b>A</b>	відмінно	зараховано	80 – 89	<b>B</b>	добре	70 – 79	<b>C</b>	60 – 69	<b>D</b>	задовільно	50 – 59	<b>E</b>	26 – 49	<b>FX</b>	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання	0-25	<b>F</b>	незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS			Оцінка за національною шкалою																									
		Для екзамену	Для заліку																										
90 – 100	<b>A</b>	відмінно	зараховано																										
80 – 89	<b>B</b>	добре																											
70 – 79	<b>C</b>																												
60 – 69	<b>D</b>	задовільно																											
50 – 59	<b>E</b>																												
26 – 49	<b>FX</b>	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання																										
0-25	<b>F</b>	незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни																										
<p>Вимоги до письмової роботи</p>	<p>Підсумкова робота може виконуватися за необхідності згідно розкладу контролю самостійної роботи (КСР) у формі тестових завдань з вибором правильної відповіді з застосуванням технічних засобів навчання. Кількість тестових завдань – 25. Вартість кожного запитання складає 1 бал. Максимальна оцінка 25 балів.</p>																												
<p>Практичні/лабораторні заняття</p>	<p>Після узагальнення (вступного слова) викладач дає відповіді на окремі теоретичні запитання, які виникли у аспірантів у процесі підготовки до заняття.</p> <p>До початку лабораторної роботи аспірант має отримати допуск за результатами усної співбесіди. На лабораторній роботі кожен аспірант отримує інструкцію до виконання. Після завершення роботи аспірант оформляє і захищає звіт з результатами роботи. Кожна лабораторна робота оцінюється за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно), середня оцінка за всі лабораторні роботи приводиться до 100-бальної шкали. Максимальний бал за лабораторні роботи 20 балів.</p>																												
<p>Умови допуску до підсумкового контролю</p>	<p>Аспірант допускається до складання заліку, якщо впродовж семестру він набрав сумарно 25 – 50 балів.</p>																												

	<p>Аспірант не допускається до складання заліку, якщо впродовж семестру він набрав менше 25 балів. У цьому випадку аспіранту у відомості робиться запис "<i>не допущений</i>" і виставляється набрана кількість балів. Допускається, як виняток, з дозволу завідувача аспірантури за заявою, погодженою з відповідною кафедрою, одноразове виконання аспірантом додаткових видів робіт з навчальної дисципліни (відпрацювання пропущених занять, виконання індивідуальних завдань тощо) для підвищення оцінок.</p> <p>Напередодні заліку викладач подає доповідну завідувачу аспірантури про недопуск аспірантів курсу спеціальності 171 "Електроніка". Відмітка про недопуск у відомості робиться при наявності розпорядження завідувача аспірантури.</p>
<p>Підсумковий контроль</p>	<p>Форма контролю – залік.</p> <p>Форма здачі – комбінована (письмова з усною співбесідою). Можливе також проведення заліку в тестовій формі з використанням технічних засобів навчання.</p> <p>Білет складається з трьох теоретичних питань і одного короткого завдання. Розподіл балів за питаннями і завданнями рівномірний. Максимальний бал за залік 50 балів.</p>
<p><b>7. Політика навчальної дисципліни</b></p>	
<p>Аспірант зобов'язаний відвідувати заняття відповідно до встановленого розкладу, не запізнюватися, мати відповідний зовнішній вигляд. У разі відсутності через хворобу надається відповідна довідка.</p> <p>Пропущена лекція відпрацьовується аспірантом самостійно, як короткий конспект за темою заняття.</p> <p>Пропущена лабораторна робота виконується аспірантом самостійно вдома або в комп'ютерній лабораторії кафедри, результати оцінюються викладачем.</p> <p>У випадку, коли аспірант приймав участь у програмі мобільності, можливе врахування отриманих оцінок в іншому навчальному закладі за умови відповідності навчальних планів або наявних сертифікатів.</p> <p><b><i>Політика академічної поведінки і етики</i></b></p> <p>Аспірант повинен бути толерантним і поважати думку інших.</p> <p>Заперечення повинні формулюватися тільки в коректній формі.</p> <p>Плагіат та академічна недоброчесність несумісні з принципами діяльності ЗВО.</p> <p>Не допускається підказування та списування під час здачі будь-яких робіт поточного, рубіжного чи підсумкового контролю.</p> <p>Не допускається користування телефонами та будь-якими іншими допоміжними засобами під час здачі будь-яких робіт поточного, рубіжного, чи підсумкового контролю.</p> <p>Також є можливість перезарахування результатів навчання в інших закладах вищої освіти чи результатів неформальної освіти згідно Положення про визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної освіти, в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (затверджено вченою радою університету 01 листопада 2022 р. протокол № 9 та введено в дію наказом ректора № 672 від 24 листопада 2022 р.).</p>	

## 8. Рекомендована література

1. М.М Погребняк, В.П Прищеп. Мікроелектроніка: ч. 1. – К.: Вища школа, 2004. – 431 с.
2. С.П. Новосядлий. Суб - і наномікронна технологія структур великих інтегральних схем: монографія. – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2010. – 456 с.
3. J. Taylor. Design of Integrated Circuits. – NY Research Press, 2023. – 267 p.
4. D. Widmann, H. Mader, H. Friedrich. Technology of Integrated Circuits. – Springer, 2000. – 330 p.
5. Л. Ткачук, Р. Закалик. Основи мікроелектроніки. – Тернопіль: Медап, 1998. – 350 с.
6. С.П. Новосядлий. Фізико-технологічні основи субмікронної технології великих інтегральних схем. – Івано-Франківськ: Сімик, 2003. – 352 с.
7. М.Г. Находкін, Д. І. Шека. Фізичні основи мікро- та наноелектроніки: підручник. Рек. МОН. – К.: Київський ун-т, 2005. – 431 с.
8. А.О. Дружинін. Твердотільна електроніка. Фізичні основи і властивості напівпровідникових приладів: навчальний посібник. – Львів: Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – 332 с.
9. П.Г. Стахів. Основи мікроелектроніки: функціональні елементи їх застосування: підручник. – Львів: 2003 – 208 с.
10. Електроніка і мікросхемотехніка: підручник /Ю.П. Колонтаєвський, А.Г. Сосков; за ред. А.Г.Соскова. – 2-е вид. Рек МОН. – К.: Каравела, 2009. – 416 с.
11. С.М. Павлов. Основи мікроелектроніки: навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 224 с.

**Викладач – професор В.І. Мандзюк**